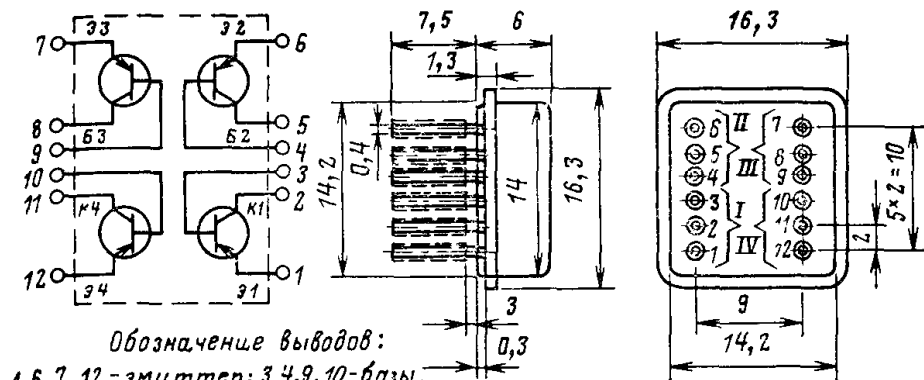


1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В

Транзисторные сборки, состоящие из четырех германиевых диффузионно-сплавных *p-n-p* переключаемых высокочастотных мало-мощных транзисторов.

Предназначены для применения в переключаемых схемах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса сборки не более 4 г.



Обозначение выводов:

1, 6, 7, 12 - эмиттер; 3, 4, 9, 10 - базы,

2, 5, 8, 11 - коллектор;

I, II, III, IV - единичный транзистор

Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_{\Sigma} = 0,5$ А не менее . . .	30 В
типичное значение	40 * В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 70$ мА 1ТС609А, ГТС609А и при $I_B = 40$ мА 1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В не более . . .	1,6 В
типичное значение	0,74 * В
Напряжение насыщения эмиттер-база при $I_K = 0,5$ А, $I_B = 70$ мА 1ТС609А, ГТС609А и при $I_B = 40$ мА, 1ТС609Б, 1ТС609В, ГТС609Б, ГТС609В не более . . .	1,1 В
типичное значение	0,57 * В

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_{Э} = 0,5$ А:

при $T = 298$ К:

1ТС609А	33–100
ГТС609А	30–100
1ТС609Б	53–160
ГТС609Б	50–160
1ТС609В	40–120
ГТС609В	80–420

при $T = 343$ К:

1ТС609А	16,5–200
1ТС609Б	26,5–370
1ТС609В	20–240

при $T = 333$ К:

ГТС609А	15–200
ГТС609Б	25–320
ГТС609В	40–480

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером:

при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_{Э} = 0,25$ А 1ТС609В, ГТС609В не менее 80

при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_{Э} = 0,7$ А 1ТС609А, ГТС609А, 1ТС609Б, ГТС609Б не менее 15

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 3$ В, $I_{К} = 0,5$ А не менее 60 МГц

Время включения при $I_{К} = 0,5$ А, $f = 2$ кГц, $I_{Б} = 70$ мА 1ТС609А, ГТС609А при $I_{Б} = 40$ мА 1ТС609Б, ГТС609Б, 1ТС609В, ГТС609В не более 0,1 мкс
 типовое значение 0,048* мкс

Время рассасывания при $I_{К} = 0,5$ А, $f = 1$ кГц, $I_{Б} = 70$ мА 1ТС609А, ГТС609А, при $I_{Б} = 40$ мА 1ТС609Б, ГТС609Б, 1ТС609В, ГТС609В не более 0,7 мкс
 типовое значение 0,343* мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 5$ МГц не более 50 пФ
 типовое значение 19,8* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{КБ} = 0$, $f = 2$ МГц не более 250 пФ
 типовое значение 111,6* пФ

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 30$ В не более:

при $T = 293$ К:

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В 30 мкА

ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В 40 мкА

при $T = 333$ К ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В 600 мкА

при $T = 343$ К 1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В 500 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 2,5$ В не более:

при $T = 293$ К:

1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В 100 мкА

ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В 200 мкА

при $T = 333$ К ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В 1000 мкА

при $T = 343$ К 1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В 500 мкА

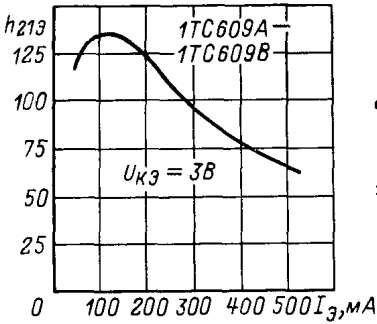
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база и коллектор-эмиттер	50 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	2,5 В
Импульсное напряжение эмиттер-база при $\tau \leq 10$ мкс	3 В
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мкс	0,7 А
Импульсный ток базы при $\tau_n \leq 10$ мкс	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность (для всей сборки) при $T \leq 316$ К	500 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность (для одного транзистора) при $\tau_n \leq 10$ мкс	5 Вт
Температура перехода	358 К
Тепловое сопротивление переход-среда	0,084 К/мВт
Температура окружающей среды:	
1ТС609А, 1ТС609Б, 1ТС609В	От 213 до 343 К
ГТС609А, ГТС609Б, ГТС609В	От 233 до 333 К

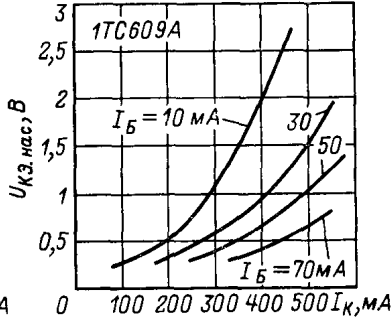
Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

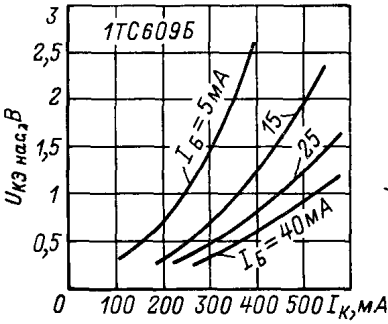
Энергоатомиздат, 1985



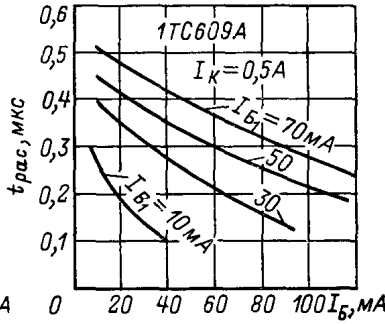
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



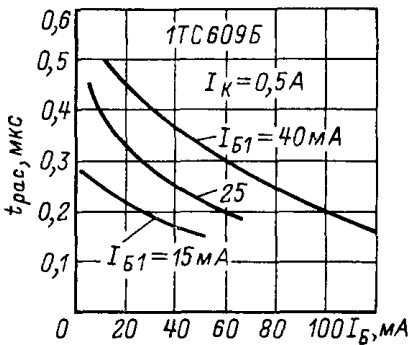
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



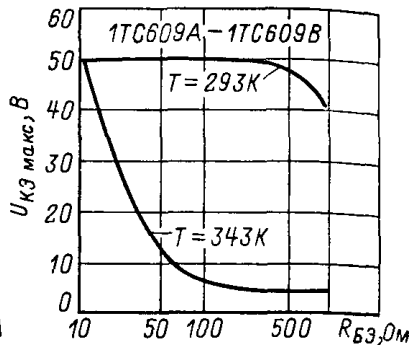
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость времени рассасывания от тока базы.



Зависимость времени рассасывания от тока базы.



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер.

Материал взят из источника: